

## Ag と Sb の電極表面時空間パターンから考察する、 静電場下における導体/絶縁体の相分離

JST 時空間秩序プロジェクト  
(京都大学大学院理学研究科物理学第一教室)

長峯 祐子<sup>1</sup>

電極表面に発生する時空間パターンに、2成分金属 Ag と Sb の電気吸着によって生じる時空間パターンがある。このパターンは、Ag と Sb を電極表面に吸着している間、発生し、動き続ける。パターンは白い縞と黒い縞から形成されている。この現象は近年発見されたが、その形成メカニズムは明らかにされていない。著者は、この時空間パターンの形成メカニズムを明らかにするために、これまでに様々な観点から、研究を行ってきた。その実験結果の1つである、パターン表面に対する元素分析結果 [1] から、この系で発生する様々な時空間パターンのうち、 $10\ \mu\text{m}$  サイズのパターン (コンプレックスラビリンス構造) が Ag と Sb の相分離から形成されている可能性を見出した。

この系は Ag と Sb を電極に吸着させるために電極に定常電場を印可している系で、非平衡開放系になっている。また、Ag と Sb では、導電率が大きく違い、更に、Sb が酸化している場合では、銀が導体で、酸化アンチモンが絶縁体であるため、「定常電場下での導体と絶縁体の相分離」によってパターンが形成されている可能性がある。従来、時空間パターンの形成メカニズムは、非平衡開放系における反応拡散系で説明されており、上記のような、「非平衡開放系の相分離」を形成メカニズムとする現象は稀である。

この研究では、パターンの形成メカニズムが「定常電場下での導体と絶縁体の相分離」である可能性を探るため、系のモデル化を行い、数値シミュレーションを行った。図1のような、電極表面に2種類の物質が吸着して電着膜を形成している系を考える。今、起電力を  $E$  とし、回路に流れる定電流を  $I_0$  とする。電極表面に形成される電着膜全体の抵抗を  $R$  とする。電着膜表面から対極までは、電解質水溶液に相当する。電着膜を形成している、2種類の物質 A、B の抵抗率をそれぞれ、 $R_A$ 、 $R_B$  とし、 $R_A$  が  $R_B$  の  $f$  倍 ( $R_A = f * R_B$ ) であるとする。また、それぞれの物質

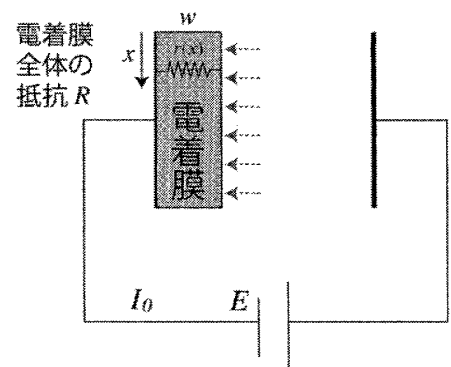


図1: 定常電場下の、導体と絶縁体で形成される電着膜の模式図

<sup>1</sup>E-mail: nagamine@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp

の濃度を  $C_A$ ,  $C_B$  と仮定し,  $C_A + C_B = \text{Cons.}$  とする。

オンサーガーの変分原理 [2] により, この系で, 最小化すべき関数  $Q$  は, 系の自由エネルギーと電着膜の抵抗によって発生する消費エネルギーであるので,  $Q$  は以下のように書ける。

$$Q(C_A(x)) = \int dx \left[ \frac{\epsilon^2}{2} (\nabla C_A)^2 + W(C_A) \right] + \frac{1}{2} R I^2 \quad (1)$$

第一項が, 界面エネルギーで,  $\epsilon$  は係数。第二項の,  $W(C_A)$  が, 内部エネルギー及びエントロピー項で, 第一項と第二項の和がこの系の自由エネルギーである。第三項が, 電着膜の抵抗によって発生する消費エネルギーで, 抵抗  $R$  は局所抵抗  $r(x)$  が  $x$  方向に並列に並んでいると仮定して  $R = 1 / \int \frac{1}{r(x)} dx$  と書ける。 $I$  は, 電着膜に流れる電流で, この系では, 定電流モードを仮定しているので, 定数になっている ( $I = I_0$ )。ここで,  $r(x) = A_0 \cdot (R_A \cdot C_A(x) + R_B \cdot C_B(x)) \times w$ ,  $A_0$  は係数,  $w$  は電着膜の厚さである。上記の関数  $Q$  を使用すると, この系の Cahn-Hilliard 方程式が以下のように記述できる。

$$\frac{\partial C_A(x)}{\partial t} = L \nabla^2 \left[ -\epsilon^2 \nabla^2 C_A + \frac{dW}{dC_A} \right] + L \nabla^2 \frac{d\bar{f}_1(C_A)}{dC_A} \quad (2)$$

$\bar{f}_1$  は空間に対して平均化された平均関数で,  $\int \bar{f}_1 dx = \frac{1}{2} [1 / \int \frac{1}{r(x)} dx] I_0^2$  のように定義される関数である。この上記の Cahn-Hilliard 方程式の計算結果と, 第3項を含まない通常の Cahn-Hilliard 方程式の計算結果と比較すると (図2), 通常の Cahn-Hilliard 方程式で, まだ相分離していない状態時に, 式 (2) で表される Cahn-Hilliard 方程式では既に, 相分離した状態を示しており, 第3項の消費エネルギーの項が, 相分離を誘起することがわかった。

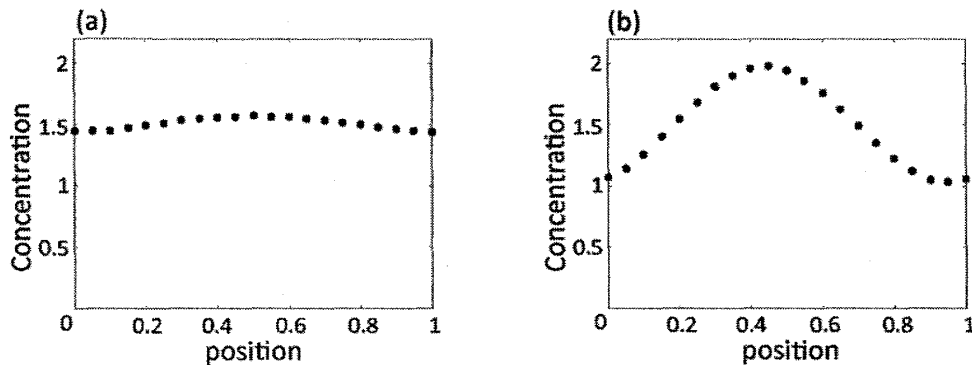


図2: 数値シミュレーション4000ステップでの計算結果。(a) 消費エネルギーが含まれない通常の Cahn-Hilliard 方程式。(b) 定常電場下の, 導体と絶縁体で形成された電着膜の消費エネルギーを考慮した Cahn-Hilliard 方程式。物質 A, B の抵抗率比  $f = 100$ 。

## 参考文献

- [1] Y. Nagamine and M. Hara, Phys. Rev. E **72** (2005), 016201.
- [2] L. Onsager, Phys. Rev. **37** (1931), 405.